BL16B2 (サンビーム BM) 産業用専用ビームライン建設利用共同体

1. はじめに

BL16B2 (サンビームBM) は、BL16XU (サンビームID) とともに13社・グループ^[脚注]で構成される産業用専用ビ ームライン建設利用共同体(サンビーム共同体)が管理・ 運営する専用ビームラインである。1998年8月に専用ビ ームライン据付工事着工申請書が承認され、BL16XU/B2 ともに設置・利用が開始され、1999年9月よりサンビー ム共同体各社への供用が開始された^[1]。2006年度に、供 用開始からのサンビームの成果をまとめるとともに、 2008年度からの10年間の次期計画を申請した。2007年 度に次期計画が承認されたことを受け、2007年度と2008 年度の2ヵ年度にわたって、大幅な設備更新・改造を実施 した^[2]。その後も、サンビーム共同体各社のニーズに合 わせて、機能向上を継続的に行っている。

2. ビームライン・実験装置の概要

BL16B2の基本仕様を表1に示す(実験装置などの機器 配置の概略はBL16XUの項の図1参照)。光源は偏向電磁 石であり、光学ハッチ内に配された可変傾斜型 Si 二結晶 単色器によって、広いエネルギー範囲で単色X線を利用で きる。光学ハッチ内には集光及び高次光除去用のベントシ リンドリカルミラーも設置されている。実験ハッチ内には、 上流側に大型実験架台、下流側に6軸X線回折装置が設置 されている。大型実験架台は、表面を平滑仕上げとし、エ アパッド浮上式のステージを採用して、測定装置類の配置 を比較的容易に変えられるような仕様となっている。その 実験架台上で、イオンチャンバーや 0-20型ゴニオメー タなどを用いて XAFS 測定を行える。XAFS 測定用の検出 器としては、他にライトル検出器、転換電子収量検出器を 備え、さらに19素子Ge半導体検出器を装備し、高感度 な蛍光 XAFS 測定に対応する。また、同じ大型実験架台で、 タンジェンシャルバー式ゴニオメータを用いてX線トポグ ラフィなどの精密X線光学実験を行うことができる。

一方、6軸X線回折装置では、通常のX線回折はもとより、X線反射率測定も行える。また、BL16XUと同様に、 COやNOなどの毒性ガスや、H₂やCH₄などの可燃性ガ スを実験ハッチに安全に供給し排気するその場計測用ガス 設備も使用できる。クィックスキャンXAFS計測系と組み 合わせて、材料の反応過程のその場XAFS測定を行える。 2012年度には、19素子Ge半導体検出器に液体窒素を 自動的に供給する装置を導入するなど、実験の利便性向上 の施策をいくつか実施した。

3. 利用状況

BL16B2における2012AB期(2012年度)の各社の実 験装置別利用割合を図1の右端に示す。それまでの年度と 同様に、XAFS装置の利用が圧倒的に多いことに変わりは ないが、2011年度に比べて、XAFS装置利用が90%程度 まで減り、その分、X線トポグラフィ装置の利用が10% 弱まで増え、残りをX線回折装置の利用が占めた。

一方、2012AB期の各社の利用研究課題の適用分野別の 比率を、2011AB期と比較して図2に示した。2011AB期 に比べて、2012AB期では、やや比率が変わったものの、 「電池」分野が最も多く、次いで「触媒・燃料電池」分野

表1. BL16B2の基本仕様 偏向電磁石 光源 光子 4.5 keV~113 keV エネルギー 可変傾斜型二結晶 単色器 (Si(111), Si(311), Si(511)) ~10¹⁰ photons/s 光子数 0.1 mm(H)×0.1 mm(V) (ミラー使用) ビームサイズ 60 mm(H)×5 mm(V) (Si(311)、ミラー不使用) 大型実験架台 (XAFS、X線トポグラフィ、X線イメージング) 実験装置·設備 6軸X線回折装置(X線反射率測定対応)

その場計測用ガス設備



図1 BL16B2における実験装置別利用割合の年度別推移。

[注] 川崎重工業(株)、(株)神戸製鋼所、住友電気工業(株)、ソニー(株)、電力グループ(関西電力(株)、(一財)電力中央研究 所)、(株)東芝、(株)豊田中央研究所、日亜化学工業(株)、日産自動車(株)、パナソニック(株)、(株)日立製作所、(株) 富士通研究所、三菱電機(株)(2013年3月現在、50音順) での利用が多いという状況に変わりはなかった。これは、 BL16B2では主にXAFSによる評価がなされているが、リ チウムイオン二次電池をはじめとした環境・エネルギー分 野の技術課題解決に有効に活用されていることの表れと考 えられる。

4. 成果の紹介、研究・技術検討事例

BL16XUの項で記したように、BL16B2で得られた成果 も、毎年主催している「サンビーム研究発表会」で報告する とともに、実験課題の成果公開の媒体である『サンビーム 年報・成果集』にて論文形式でも発表している。2012年 度には、第12回サンビーム研究発表会(第9回 SPring-8 産業利用報告会、2012年9月6日~7日、名古屋市愛知 芸術文化センター)にて、ポスター発表21件、口頭発表 6件を行うとともに、『サンビーム年報・成果集 vol. 2 2012』を発刊した^[3]。これらの成果は、それより過去の 分も含めて、サンビーム共同体ホームページでも公開され ている^[4]。

以下に研究事例と技術検討事例を紹介する。

 Ni表面に underpotential deposition した Pb 単原子 層の in-situ XAFS 解析^[5]

underpotential deposition (UPD) とは、水溶液中の 金属イオンが金属として電析する平衡電位よりも高い電位 領域で異種金属上に単原子層程度析出する特異現象であ る。実用金属の腐食(応力腐食割れ、水素脆化等)や電気 めっき膜の性能にUPDの関与が考えられるが、腐食を伴 う実用金属上のUPDの研究はこれまで皆無に近い。今回、 in-situ XAFS 解析により、Ni表面上へのPbのUPD現象 を世界で初めて捉えることに成功した。

Ni めっきした Ni 板を酸でエッチングすることにより、 表面粗度の大きな Ni 電極を作製した。アルゴンガスで脱 気した 0.1 M NaClO₄ + 10⁻² M HClO₄ + 10⁻⁴ M Pb²⁺水 溶液中で Ni 電極の電位を一定に保持しながら、液面を周 期的に変動させて液から露出した Ni 部位に放射光を照射 し、Pb LIII 吸収端 XAFS スペクトルを蛍光法により測定 した。

図3は、電位をPb析出の平衡電位よりも60 mV高い -0.185 V (SHE) に保持したNi電極のPb LIII吸収端 XANES スペクトルを、Pb 箔及び10⁻⁴ M Pb²⁺水溶液のス ペクトルと比較した結果である。スペクトルの比較から、 Ni電極上に析出したPb は金属状態であることが明らかで ある。また、EXAFS解析から、析出したPb 原子の一部は Ni 原子と表面合金を形成することが示唆されることも判 明した。

(2) 二次元イメージング XAFS 法の検討^[6]

二次元イメージングXAFS法は、X線イメージング技術 とXAFSを組み合わせた測定手法である。X線カメラ等の 二次元検出器を用いることで、観察視野内におけるXAFS スペクトルを一度のスキャンで取得でき、特に面内で分布 を持つ試料の状態評価に対して有効である。BL16B2にお いてこれまでも各社利用で個別に試みられてきた手法だ が、2011年度にX線カメラを更新し、感度・ダイナミッ クレンジが向上したことを受けて、共同体の基盤技術とし て確立する検討を2012年度に行った。









図4 観察された鉄酸化物の透過像(X線エネルギー7140 eV)。



図5 透過像の各領域から得られた XANES スペクトル(左図)と動径構造関数(右図)。

光学系として、前置ミラーの無い場合、集光ミラーを用 いた場合、及び平面ミラーを用いた場合の比較を行った。 その結果、平面ミラーを用いると、視野は狭くなるが、強 度が高く、視野内のエネルギーの不均一性の小さい入射X 線が得られ、二次元イメージングXAFS法に適しているこ とが分かった。

この光学系を採用して、複数の鉄酸化物試薬を粉砕・混 合したものを用い、X線カメラを検出器とした透過配置で Fe K吸収端のXAFS測定を行った。得られた画像の一例 を図4に示す。コントラストの異なる3点において、各点 100 μm角の領域から抽出したXANESスペクトルと EXAFS振動から得た動径構造関数を図5に示す。画像コ ントラスト、XANES形状及び動径構造関数のいずれにお いても差異が認められ、各点は図4に付記したような異な る鉄酸化物であることが確認できた。

本技術検討により、本手法を未経験の場合でも実施でき るようになり、今後、各社の利用実験における一層の活用 が見込まれる。 参考文献

- [1] 泉 弘一: SPring-8利用者情報 Vol.4, No.4 (1999) 20;
 久保 佳実: ibid. Vol.6, No.2 (2001) 103.
- [2] 飯原 順次、他:第22回日本放射光学会年会・放射光
 科学合同シンポジウム、11P012 (2009.1.9~12、
 東京大学);他 同合同シンポジウム11P021,12P027,12P028,12P029,12P030,12P031,12P032.
- [3] 『サンビーム年報・成果集 Vol.2 2012』産業用専用 ビームライン建設利用共同体発行)。第12回サンビー ム研究発表会の報告部分はpp. 107-149に記載。
- [4] サンビーム研究成果公開WEBサイト http://sunbeam.spring8.or.jp/top/seika.html
- [5] 瀬尾 眞浩、中山 武典:第12回サンビーム研究発表会 (第9回 SPring-8産業利用報告会)、講演番号 S-02 (2012.9.6、7、愛知芸術文化センター).
- [6] 高尾 直樹、他:第26回日本放射光学会年会・放射光
 科学合同シンポジウム、14P108 (2013.1.12~14、
 名古屋大学)

ソニー株式会社 先端マテリアル研究所 工藤 喜弘